

01;04;09

## Поверхностные волны на движущемся плазменном слое

© И.Л. Шейнман, А.Д. Канарейкин, Е.А. Сизова

С.-Петербургский государственный электротехнический университет

Поступило в Редакцию 29 января 1999 г.

Рассмотрены устойчивые и неустойчивые поверхностные электромагнитные волны на границе плоского движущегося плазменного слоя. Показано, что в отличие от одиночного тангенциального разрыва скорости внутри слоя могут существовать как медленные, так и быстрые волны. Максимальный пространственный инкремент нарастания колебаний достигается при направлениях распространения волн, отличных от направления движения слоя. Симметричные и антисимметричные относительно плоскости симметрии слоя волны имеют разные критические углы, начиная с которых развивается их нарастание; область углов, где поток устойчив, определяется меньшим из них.

Возникновение поверхностной электромагнитной волны вблизи плоской границы раздела двух сред связано с наличием мнимой части у поверхностного импеданса [1], что соответствует случаю комплексного показателя преломления одной из сред [2]. В отсутствие потерь такая ситуация возможна, если диэлектрическая проницаемость  $\epsilon < 0$ , т.е. для плазменной среды. При положительных значениях диэлектрической проницаемости обеих неподвижных граничащих сред возбуждение поверхностных волн вблизи границы невозможно. Релятивистское движение одной из сред приводит к возможности возбуждения электромагнитной поверхностной волны даже на тангенциальном разрыве скорости однородной среды с  $\epsilon > 0$  [3]. В этом случае необходимым условием существования поверхностных волн является возникающая анизотропия, связанная с появлением выделенного направления движения среды [4]. При этом волны могут распространяться только в направлениях, составляющих с направлением движения среды углы, превышающие некоторый критический угол.

Кроме устойчивых волн на тангенциальном разрыве скорости существуют нарастающие поверхностные электромагнитные волны, приводящие к гидродинамической неустойчивости релятивистских плазменных

потоков [5]. Для плоского слоя релятивистское движение относительно неподвижной внешней среды порождает его неустойчивость из-за возбуждения удаляющихся от границы волн во внешней диэлектрической среде (черенковская неустойчивость) [6] или поверхностных волн, если неподвижной средой является плазма [7], однако проведенный в [6,7] анализ относился только к случаю коллинеарных скорости и волнового вектора.

Рассмотрим движущийся плоский плазменный слой толщиной  $2h$  с диэлектрической проницаемостью  $\varepsilon_2$  и скоростью  $\mathbf{V} = \beta c$  в неподвижной среде с диэлектрической проницаемостью  $\varepsilon_1$ . В прямоугольной системе координат скорость имеет вид  $\beta = (0, \beta_y, \beta_z)$ , волновой вектор  $\mathbf{k}_\perp$  направлен вдоль оси  $z$ . Из уравнений Максвелла для движущейся среды и граничных условий получим:

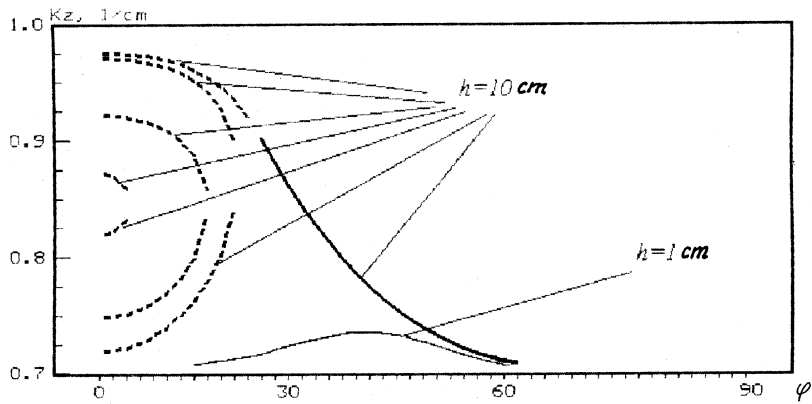
$$(\varepsilon_2 \kappa_1 S + \varepsilon_1 \kappa_2)(\kappa_1 S^{-1} + \kappa_2) = (\varepsilon_2 - 1)(\varepsilon_1 - 1) \eta^2 \gamma^2 \beta_y^2, \quad (1)$$

где  $\kappa_1^2 = \eta^2 - \varepsilon_1$ ,  $\kappa_2^2 = \eta^2 - 1 - (\varepsilon_2 - 1) \gamma^2 (1 - \eta \beta_z)^2$ ,  $\eta = k_z/k$ ,  $k = \omega/c$ ,  $k_z = |\mathbf{k}_\perp|$ ,  $\gamma = (1 - \beta^2)^{-1/2}$ .

Уравнение (1) представляет собой дисперсионное уравнение для поверхностных волн в плоском волноводе, заполненном движущейся плазменной средой, и описывает волны с симметричной ( $S = \text{cth}(kh\kappa_2)$ ) и антисимметричной ( $S = \text{th}(kh\kappa_2)$ ) относительно плоскости  $yOz$  компонентой поля  $E_z$ . В случае тангенциального разрыва скорости однородной среды, т.е. при  $\varepsilon_1 = \varepsilon_2$ , уравнения (1) для симметричных и антисимметричных волн совпадают. При  $h \rightarrow +\infty$  взаимное влияние границ становится пренебрежимо малым и (1) переходит в дисперсионное уравнение для поверхностных волн на плоской границе раздела двух сред, движущихся друг относительно друга [3]:

$$(\varepsilon_2 \kappa_1 + \varepsilon_1 \kappa_2)(\kappa_1 + \kappa_2) = (\varepsilon_2 - 1)(\varepsilon_1 - 1) \eta^2 \gamma^2 \beta_y^2. \quad (2)$$

На рис. 1 приведены зависимости постоянной распространения  $k_z$  от угла  $\varphi$  между  $\mathbf{k}_\perp$  и  $\mathbf{V}$  для поверхностных волн на движущем слое ( $k = 1 \text{ см}^{-1}$ ,  $\beta = 0.941$ ,  $\gamma = 2.96$ ,  $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = 0.5$ ). Экспоненциально спадающие по амплитуде с удалением от границ вне слоя поверхностные волны внутри него могут быть двух типов: медленные поверхностные при  $\kappa_2^2 > 0$  и быстрые объемные при  $\kappa_2^2 < 0$ . В отличие от одиночного тангенциального разрыва скорости, где поверхностные волны не могли распространяться под углами, меньшими некоторого критического угла



**Рис. 1.** Зависимости постоянной распространения  $k_z$  от угла  $\varphi$  между  $\mathbf{k}_\perp$  и  $\mathbf{V}$  для плоского движущегося слоя при  $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = 0.5$ ,  $k = \omega/c = 1 \text{ cm}^{-1}$ ,  $\gamma = 3$ ,  $\beta = 0.941$ : —  $\kappa_2^2 > 0$  (медленные волны), - - -  $\kappa_2^2 < 0$  (быстрые волны),  $h = 10 \text{ cm}$ ; —  $\kappa_2^2 > 0$  (медленные волны),  $h = 1 \text{ cm}$ .

$\varphi_k$  между  $\mathbf{k}_\perp$  и  $\mathbf{V}$  [3], для поверхностных волн на слое критический угол  $\varphi_k$  соответствует переходу от быстрых волн к медленным волнам. Наибольший критический угол достигается при  $S \approx \sqrt{\varepsilon_1 \varepsilon_2}$ , что при  $\varepsilon_1 = \varepsilon_2$  дает  $h \rightarrow +\infty$ . Уменьшение толщины слоя ведет к снижению критического угла, при малых  $h$  быстрые объемные волны не возникают.

Кроме устойчивых, уравнения (1) могут иметь также нарастающие во времени или в пространстве решения, приводящие к возникновению абсолютной и конвективной неустойчивостей плазменного слоя. Аналитические выражения для плазменной внешней среды могут быть получены в предельных случаях высоких и низких частот подстановкой выражений для диэлектрической проницаемости неподвижной и движущейся плазмы в уравнение (2). Тогда при вещественных  $k$  имеем

$$\eta = \beta_z^{-1} \left[ 1 \pm ik_{p2} k^{-1} \gamma^{-1} \left( (k^2 + k_{p1}^2 \beta_y^2) / (k_{p1}^2 - 2k^2) \right)^{1/2} \right], \quad (3)$$

где  $k \ll k_{p1}$ ,  $k \ll k_{p2}$  и при  $k \gg k_{p1}$ ,  $k \gg k_{p2}$ .

В случае, когда  $k_z \ll k_{p1}$ ,  $k_z \ll k_{p2}$  и  $k \ll k_{p1}$ ,  $k \ll k_{p2}$ , решение можно представить в виде

$$\eta = \left[ \beta_z(1+\nu) \pm i \left( \nu \beta^2(1+\nu)(1-\beta_z^2 + \nu(1-\beta^2)) \right)^{1/2} \right] \left( \beta_z^2 + \nu \beta^2 \right)^{-1}, \quad (4)$$

где  $\nu = k_{p2}/k_{p1}$ ,  $k_{p1}^2 = 4\pi e^2 n_1 / mc^2$ ,  $k_{p2}^2 = 4\pi e^2 n_2 / m\gamma c^2$ ,  $n_1$  и  $n_2$  — концентрации электронов вне и внутри слоя,  $e$  — заряд,  $m$  — масса электрона.

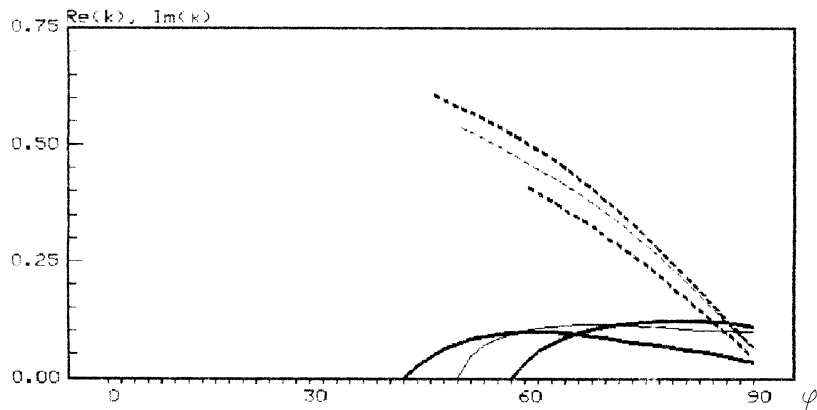
Отметим, что в этих случаях максимальный пространственный инкремент нарастания колебаний достигается при  $\beta_z \rightarrow 0$ ,  $\beta_y = \beta$ . При этом из (4) получаем  $\text{Im}(\eta) = (1 + \nu\gamma^{-2})(1 + \nu)\gamma/\beta^2$ .

Находя комплексные решения (1) в виде возмущений частоты волны, фазовая скорость которой равна скорости движения слоя в направлении ее распространения  $k = k_0 + k_*$ ,  $|k_*| \ll k_0$ ,  $k_0 = \beta_z k_z$ ;  $\beta_{ph} = \frac{k}{k_*} \approx \frac{k_0}{k_*} = \beta_z$ , получим

$$k_* = \frac{k_{p2}}{\gamma} \left( \frac{\kappa_1^2 + \kappa_1 \kappa_2 S - (\varepsilon_1 - 1)\gamma^2 \beta_y^2 / \beta_z^2}{(\kappa_1 S + \varepsilon_1 \kappa_2)(\kappa_1 S^{-1} + \kappa_2)} \right)^{1/2}, \quad (5)$$

где  $\kappa_1^2 = (1 - \varepsilon_1 \beta_z^2) / \beta_z^2$ ,  $\kappa_2^2 = (1 - \beta_z^2) / \beta_z^2 + k_{p2}^2 / k_0^2$ . Таким образом, для возникновения резонансной неустойчивости волны необходимо либо  $\varepsilon_1 < 0$ , либо  $\varepsilon_1 > 1$ , т.е. диэлектрической внешней среде.

На рис. 2 приведены полученные на основе численного решения уравнений (1) и (2) зависимости вещественной и мнимой частей  $k$  при фиксированной вещественной постоянной распространения  $k_z$  от угла  $\varphi$  между  $\mathbf{k}_\perp$  и  $\mathbf{V}$  для поверхностных волн на тангенциальном разрыве скорости двух сред и движущемся плазменном слое при  $k_z = 1 \text{ см}^{-1}$ ,  $n_1 = n_2 = 1.4 \cdot 10^{11} \text{ см}^{-1}$ ,  $\beta = 0.999$ ,  $\gamma = 22.4$ ,  $h = 1 \text{ см}$ . В ультрарелятивистском случае тангенциальный разрыв скорости является устойчивым по отношению к поверхностным волнам с волновым вектором, параллельным скорости движения среды, но неустойчивым по отношению к волнам, распространяющимся под углами, большими некоторого критического угла  $\varphi$ . Для плазменного слоя симметричные и антисимметричные относительно плоскости  $yOz$  волны имеют разные критические углы, начиная с которых развивается их нарастание. Область углов, где поток устойчив, определяется меньшими из них.



**Рис. 2.** Зависимости вещественной и мнимой частей  $k = \omega/c$  от угла  $\varphi$  между  $\mathbf{k}_\perp$  и  $\mathbf{V}$  для волн на тангенциальном разрыве скорости и на плоском движущемся слое при  $\beta = 0.999$  ( $\gamma = 22.4$ ),  $k_z = 1$  см,  $n_1 = n_2 = 1.4 \cdot 10^{11}$  см,  $h = 1$  см: — — —  $\text{Im}(k)$ , — — —  $\text{Re}(k)$ , плоский движущийся слой; — — —  $\text{Im}(k)$ , — — —  $\text{Re}(k)$ , тангенциальный разрыв скорости.

Исследованный тип поверхностных волн может быть использован в устройствах релятивистской плазменной СВЧ-электроники для генерации электромагнитных волн в направлениях, отличных от направления движения плазменного слоя.

## Список литературы

- [1] Марков Г.Т., Чаплин А.Ф. Возбуждение электромагнитных волн. М.—Л.: Энергия, 1967. 376 с.
- [2] Солименко С., Крозиныани Б., Ди Порто П. Дифракция и волноводное распространение оптического излучения / Пер. с англ. М.: Мир, 1989. 664 с.
- [3] Барсуков К.А., Канарейкин А.Д. // ЖТФ. 1985. Т. 55. № 9. С. 1847–1849.
- [4] Канарейкин А.Д., Шейнман И.Л. // Письма в ЖТФ. 1996. Т. 22. В. 2. С. 61–64.
- [5] Канарейкин А.Д., Шейнман И.Л. // Письма в ЖТФ. 1997. Т. 23. В. 5. С. 76–79.
- [6] Кондратенко А.Н., Куклин В.М. Основы плазменной электроники. М.: Энергоатомиздат, 1988. 320 с.
- [7] Гавриленко В.Г., Лупанов Г.А., Степанов Е.С. // Изв. вузов. Радиофизика. 1970. Т. XIII. № 5. С. 700–705.